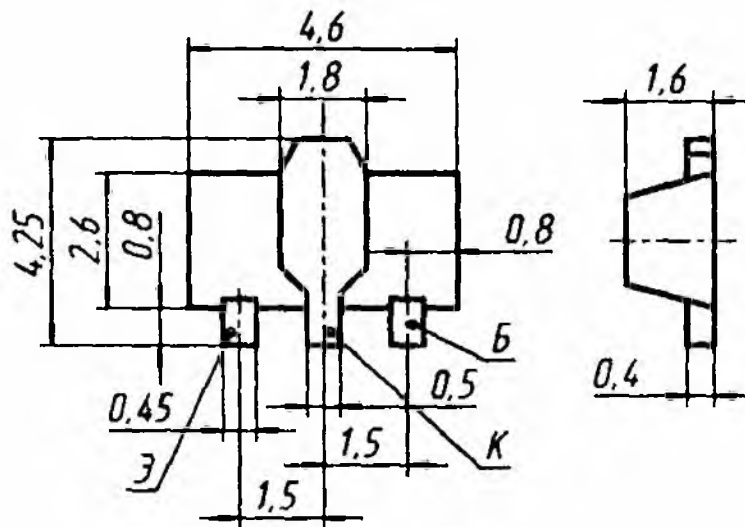


## 2Т664А9, 2Т664Б9, КТ664А9, КТ664Б9

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры *p-n-p* универсальные. Предназначены для применения в усилителях и переключающих устройствах. Выпускаются в пластмассовом корпусе с жесткими выводами. На корпусах транзисторов наносят условные знаки: 2Т664А9 — 2А, 2Т664Б9 — 2Б, КТ664А9 — КА, КТ664Б9 — КБ. Тип прибора указывается на этикетке.

Масса транзистора не более 0,1 г.

2Т664(А9,Б9), КТ664(А9,Б9)



### Электрические параметры

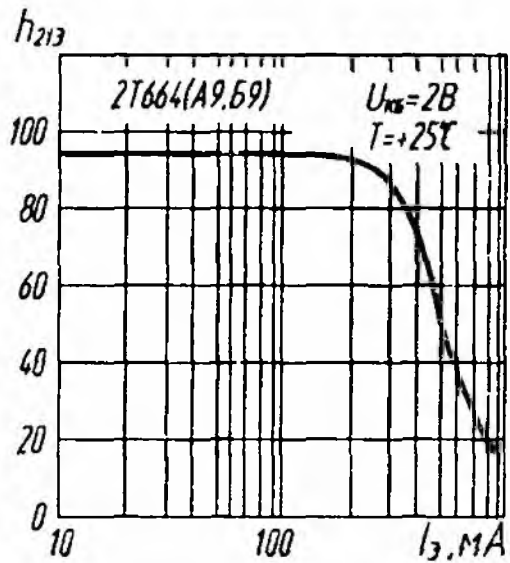
Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{КБ} = 2$ В, $I_3 = 0,15$ А .....	40...250
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $U_{КБ} = 5$ В, $I_3 = 50$ А, типовое значение .....	140* МГц
Граничное напряжение при $I_3 = 30$ мА, не менее:	
2Т664А9, КТ664А9 .....	80 В
2Т664Б9, КТ664Б9 .....	60 В
Напряжение насыщения коллектор—эмиттер при $I_К = 0,15$ А, $I_Б = 15$ мА, не более .....	0,3 В
Напряжение насыщения база—эмиттер при $I_К = 0,15$ А, $I_Б = 15$ мА, не более .....	1,1 В
Время включения при $U_{КЭ} = 20$ В, $I_К = 0,2$ А, $I_Б = 40$ мА, не более .....	0,1 мкс

Время выключения при $U_{кз} = 20 \text{ В}$ , $I_k = 0,2 \text{ А}$ , $I_b = 40 \text{ мА}$ , не более .....	0,7 мкс
Время спада при $U_{кз} = 20 \text{ В}$ , $I_k = 0,2 \text{ А}$ , $I_b = 40 \text{ мА}$ , не более .....	0,3 мкс
Емкость коллекторного перехода при $U_{кб} = 5 \text{ В}$ , не более .....	25 пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{бэ} = 0,5 \text{ В}$ , не более .....	150 пФ
Обратный ток коллектора при $U_{кб} = 100 \text{ В}$ , не более .....	10 мкА
Обратный ток эмиттера при $U_{эб} = 5 \text{ В}$ , не более .....	10 мкА

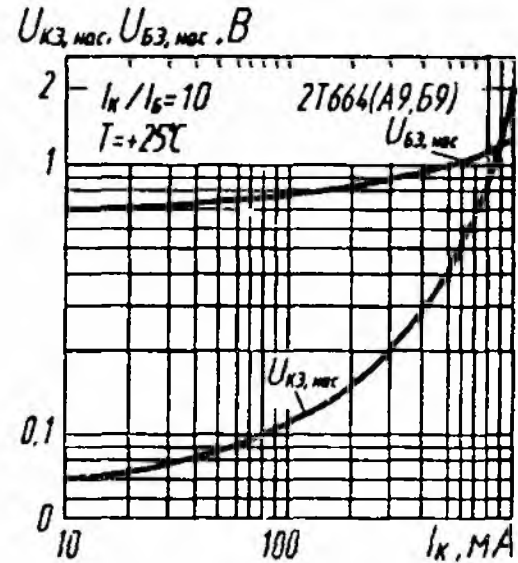
### Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—база:	
2Т664А9, КТ664А9 .....	120 В
2Т664Б9, КТ664Б9 .....	100 В
Постоянное напряжение коллектор—эмиттер:	
при $R_{бэ} = 1 \text{ кОм}$ :	
2Т664А9, КТ664А9 .....	100 В
2Т664Б9, КТ664Б9 .....	80 В
при $R_{бэ} = \infty$ :	
2Т664А9, КТ664А9 .....	80 В
2Т664Б9, КТ664Б9 .....	60 В
Постоянное напряжение эмиттер—база .....	5 В
Постоянный ток коллектора .....	1 А
Импульсный ток коллектора при $t_{и} = 10 \text{ мс}$ .....	1,5 А
Постоянный ток базы .....	0,3 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $T = -60...+25 \text{ °С}$ :	
с теплоотводом .....	1 Вт
без теплоотвода .....	0,3 Вт
Температура $p-n$ перехода .....	+150 °С
Температура окружающей среды .....	-60... $T_k =$ = +100 °С

Транзисторы являются комплементарными с транзисторами 2Т665А9, 2Т665Б9, КТ665А9, КТ665Б9.



Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера



Зависимости напряжения насыщения коллектор—эмиттер и база—эмиттер от тока коллектора